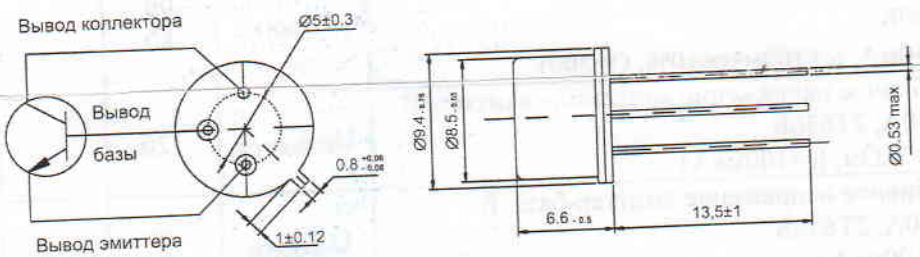
Транзистор 2Т630А, 2Т630Б

Этикетка

1. Общие сведения.

Кремниевые планарные n-p-n транзисторы типов 2Т630А, 2Т630Б в металлостеклянном корпусе, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах.



Масса не более 1,45 г.

conector.by

2. Основные технические данные.

Электрические параметры при температуре $t_{ОКР}$=(25±10)°С.

Наименование параметра, единица измерения, тип транзистора, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		Не менее	Не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером 2Т630А 2Т630Б ($U_{КЭ}$=10В, $I_К$=150мА)	$h_{21Э}$	40 80	120 240
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА 2Т630А, 2Т630Б ($U_{КЭ}$=90В, $R_{БЭ}$≤3кОм)	$I_{КЭR}$		1
Обратный ток эмиттера, мкА 2Т630А, 2Т630Б ($U_{ЭБ}$=5В)	$I_{ЭБО}$		0.1
Граничное напряжение, В 2Т630А 2Т630Б ($I_Э$=30мА, t_U≤100мкс±10%, Q≥200)	$U_{КЭОГР}$	90 80	
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($R_{БЭ}$=3кОм, $I_К$=100мкА)	$U_{КЭRОПРОБ}$	120	
Пробивное напряжение эмиттер-база, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_Э$=100мкА)	$U_{ЭБОПРОБ}$	7	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_К$=150мА, $I_Б$=15мА)	$U_{КЭНАС}$		0.3
Напряжение насыщения база-эмиттер, В 2Т630А, 2Т630Б ($I_К$=150мА, $I_Б$=15мА)	$U_{БЭНАС}$		1.1

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов: золото [redacted].

3. Сведения о приемке.

Транзисторы 2Т630А, 2Т630Б соответствуют техническим условиям ЮФ3.365.043ТУ

Штамп ОТК ВТК 128

Штамп ПЗ 5

conector.by